

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02012/036207

発行日 平成26年2月3日 (2014.2.3)

(43) 国際公開日 平成24年3月22日 (2012.3.22)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
HO 1 L 21/822 (2006.01)	HO 1 L 27/04	L 5 E 0 7 0
HO 1 L 27/04 (2006.01)	HO 1 F 17/00	B 5 F 0 3 8
HO 1 F 17/00 (2006.01)	HO 3 F 3/45	Z 5 J 5 0 0
HO 3 F 3/45 (2006.01)		

審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 25 頁)

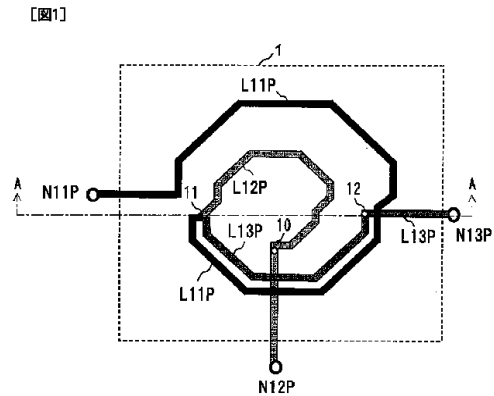
出願番号 特願2012-534037 (P2012-534037)	(71) 出願人 000004226 日本電信電話株式会社 東京都千代田区大手町二丁目3番1号
(21) 国際出願番号 PCT/JP2011/070993	
(22) 国際出願日 平成23年9月14日 (2011.9.14)	(71) 出願人 504132272 国立大学法人京都大学 京都府京都市左京区吉田本町36番地1
(31) 優先権主張番号 特願2010-209549 (P2010-209549)	(74) 代理人 100064621 弁理士 山川 政樹
(32) 優先日 平成22年9月17日 (2010.9.17)	(74) 代理人 100098394 弁理士 山川 茂樹
(33) 優先権主張国 日本国 (JP)	(74) 代理人 100153006 弁理士 小池 勇三
	(72) 発明者 大友 祐輔 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日本電信電話株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 インダクタ

(57) 【要約】

インダクタ(1)は、インダクタ領域の外周にスパイラルの形状に形成され、始点が端子(N11P)と接続されたインダクタ(L11P)と、インダクタ(L11P)の終点を始点としてインダクタ領域の内周にスパイラルの形状に形成され、終点が端子(N12P)と接続されたインダクタ(L12P)と、インダクタ(L11P)とインダクタ(L12P)との接続点を始点としてインダクタ(L11P)とインダクタ(L12P)とに挟まれる領域にスパイラルの形状に形成され、終点が端子(N13P)と接続されたインダクタ(L13P)とを備える。



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

インダクタ領域の外周にスパイラルの形状に形成され、始点が第 1 の端子と接続された第 1 のインダクタ配線と、

この第 1 のインダクタ配線の終点を始点として前記インダクタ領域の内周にスパイラルの形状に形成され、終点が第 2 の端子と接続された第 2 のインダクタ配線と、

前記第 1 のインダクタ配線と前記第 2 のインダクタ配線との接続点を始点として前記第 1 のインダクタ配線と前記第 2 のインダクタ配線とに挟まれる領域にスパイラルの形状に形成され、終点が第 3 の端子と接続された第 3 のインダクタ配線とを備えることを特徴とするインダクタ。

10

【請求項 2】

請求項 1 記載のインダクタにおいて、

前記第 3 のインダクタ配線は、前記第 1 のインダクタ配線の内側に沿って前記第 1 のインダクタ配線と逆巻きに形成されることを特徴とするインダクタ。

【請求項 3】

請求項 1 記載のインダクタにおいて、

さらに、前記インダクタ領域の外周にスパイラルの形状に形成され、始点が第 4 の端子と接続された第 4 のインダクタ配線と、

この第 4 のインダクタ配線の終点を始点として前記インダクタ領域の内周にスパイラルの形状に形成され、終点が第 5 の端子と接続された第 5 のインダクタ配線と、

20

前記第 4 のインダクタ配線と前記第 5 のインダクタ配線との接続点を始点として前記第 4 のインダクタ配線と前記第 5 のインダクタ配線とに挟まれる領域にスパイラルの形状に形成され、終点が第 6 の端子と接続された第 6 のインダクタ配線とを備え、

前記第 4 のインダクタ配線は、前記第 1 乃至第 6 のインダクタ配線のスパイラルの中心を通る直線であって且つこのスパイラルが形成された平面と平行な直線に関して、前記第 1 のインダクタ配線と線対称に形成され、

前記第 5 のインダクタ配線は、前記直線に関して前記第 2 のインダクタ配線と線対称に形成され、

前記第 6 のインダクタ配線は、前記直線に関して前記第 3 のインダクタ配線と線対称に形成されることを特徴とするインダクタ。

30

【請求項 4】

請求項 3 記載のインダクタにおいて、

前記第 6 のインダクタ配線は、前記第 4 のインダクタ配線の内側に沿って前記第 4 のインダクタ配線と逆巻きに形成されることを特徴とするインダクタ。

【請求項 5】

請求項 1 記載のインダクタにおいて、

前記第 1 乃至第 3 の各インダクタ配線は、第 1 の金属配線層を用いて形成され、他のインダクタ配線と交差する箇所のみコンタクトを介して第 2 の金属配線層に退避するように形成されることを特徴とするインダクタ。

【請求項 6】

40

請求項 3 記載のインダクタにおいて、

前記第 1 乃至第 6 の各インダクタ配線は、第 1 の金属配線層を用いて形成され、他のインダクタ配線と交差する箇所のみコンタクトを介して第 2 の金属配線層に退避するように形成されることを特徴とするインダクタ。

【請求項 7】

差動信号が入力される差動構成の第 1、第 2 のトランジスタと、

この第 1、第 2 のトランジスタに定電流を供給する電流源と、

一端が電源に接続された第 1、第 2 の負荷抵抗と、

第 1 の端子が正相側の前記第 1 のトランジスタの出力端子に接続され、第 2 の端子が前記第 1 の負荷抵抗の他端に接続され、第 3 の端子が回路の正相側の出力端子に接続された

50

第 1 のインダクタと、

第 1 の端子が逆相側の前記第 2 のトランジスタの出力端子に接続され、第 2 の端子が前記第 2 の負荷抵抗の他端に接続され、第 3 の端子が回路の逆相側の出力端子に接続された第 2 のインダクタとを備え、

各インダクタは、インダクタ領域の外周にスパイラルの形状に形成され、始点が前記第 1 の端子と接続された第 1 のインダクタ配線と、

この第 1 のインダクタ配線の終点を始点として前記インダクタ領域の内周にスパイラルの形状に形成され、終点が前記第 2 の端子と接続された第 2 のインダクタ配線と、

前記第 1 のインダクタ配線と前記第 2 のインダクタ配線との接続点を始点として前記第 1 のインダクタ配線と前記第 2 のインダクタ配線とに挟まれる領域にスパイラルの形状に形成され、終点が前記第 3 の端子と接続された第 3 のインダクタ配線とを備え、

前記第 1、第 2 のインダクタを別個のインダクタ領域に形成することを特徴とするピーキング回路。

【請求項 8】

差動信号が入力される差動構成の第 1、第 2 のトランジスタと、

この第 1、第 2 のトランジスタに定電流を供給する電流源と、

一端が電源に接続された第 1、第 2 の負荷抵抗と、

第 1 の端子が正相側の前記第 1 のトランジスタの出力端子に接続され、第 2 の端子が前記第 1 の負荷抵抗の他端に接続され、第 3 の端子が回路の正相側の出力端子に接続された第 1 のインダクタと、

第 4 の端子が逆相側の前記第 2 のトランジスタの出力端子に接続され、第 5 の端子が前記第 2 の負荷抵抗の他端に接続され、第 6 の端子が回路の逆相側の出力端子に接続された第 2 のインダクタとを備え、

前記第 1 のインダクタは、

インダクタ領域の外周にスパイラルの形状に形成され、始点が前記第 1 の端子と接続された第 1 のインダクタ配線と、

この第 1 のインダクタ配線の終点を始点として前記インダクタ領域の内周にスパイラルの形状に形成され、終点が前記第 2 の端子と接続された第 2 のインダクタ配線と、

前記第 1 のインダクタ配線と前記第 2 のインダクタ配線との接続点を始点として前記第 1 のインダクタ配線と前記第 2 のインダクタ配線とに挟まれる領域にスパイラルの形状に形成され、終点が前記第 3 の端子と接続された第 3 のインダクタ配線とを備え、

前記第 2 のインダクタは、

前記インダクタ領域の外周にスパイラルの形状に形成され、始点が前記第 4 の端子と接続された第 4 のインダクタ配線と、

この第 4 のインダクタ配線の終点を始点として前記インダクタ領域の内周にスパイラルの形状に形成され、終点が前記第 5 の端子と接続された第 5 のインダクタ配線と、

前記第 4 のインダクタ配線と前記第 5 のインダクタ配線との接続点を始点として前記第 4 のインダクタ配線と前記第 5 のインダクタ配線とに挟まれる領域にスパイラルの形状に形成され、終点が前記第 6 の端子と接続された第 6 のインダクタ配線とを備え、

前記第 4 のインダクタ配線は、前記第 1 乃至第 6 のインダクタ配線のスパイラルの中心を通る直線であって且つこのスパイラルが形成された平面と平行な直線に関して、前記第 1 のインダクタ配線と線対称に形成され、

前記第 5 のインダクタ配線は、前記直線に関して前記第 2 のインダクタ配線と線対称に形成され、

前記第 6 のインダクタ配線は、前記直線に関して前記第 3 のインダクタ配線と線対称に形成されることを特徴とするピーキング回路。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、光受信モジュールに用いるトランスインピーダンスアンプや光送信モジュール

10

20

30

40

50

ルに用いるレーザー駆動回路などの高周波信号を扱う半導体集積回路において金属配線層を用いて形成するインダクタを主な適用先とし、特に高い周波数応答を実現するピーキング回路に必須なインダクタに関するものである。

【背景技術】

【0002】

シリコンCMOSトランジスタは、集積度が高く、大量生産した場合に安価に半導体集積回路を提供できるという特長を持つ。一方で、シリコンCMOSトランジスタは、InP等に代表される化合物半導体を用いたトランジスタと比較すると遮断周波数が低く、回路の動作周波数が低くなる。この欠点を解決するため、金属配線をスパイラル状に巻いてインダクタを形成し、このインダクタをトランジスタの負荷抵抗や帰還抵抗などに付加してピーキング回路を作製して、帯域を延伸する手法が広く用いられている。このようなスパイラルインダクタによるピーキング回路によれば、インダクタを使用する前と比較して半導体集積回路の帯域を2倍程度延伸することが可能となる。しかし、インダクタの面積はトランジスタの面積と比較して著しく大きいので、半導体集積回路の面積が大きくなり、半導体集積回路のコストが高くなるという問題点があった。

10

【0003】

「Jaeha Kim, et.al., “Design Optimization of On-Chip Inductive Peaking Structures for 0.13- μ m CMOS 40-Gb/s Transmitter Circuits”, IEEE Transactions on Circuits and Systems-I, Vol.56, No.12, pp.2544-2555, December 2009」(以下、文献1と呼ぶ)に開示された従来のインダクタの平面図を図11A、図11Bに示す。図11C、図11Dは、それぞれ図11A、図11Bのインダクタの等価回路図である。図11A、図11Bの端子a, b, cは、図11C、図11Dの端子a, b, cと対応している。図11A~図11Dにおいて、ピーキングに使用するインダクタはL1とL2の2個である。図11C、図11Dにおけるkは、インダクタL1とインダクタL2との間の結合係数である。

20

【0004】

図11Aの例では、この2個のインダクタL1, L2を1個のインダクタスパイラルに連続して巻いて形成している。一方、図11Bの例では、インダクタL2を形成する際、インダクタL1と巻き方を逆にするにより、図11Aの例に対してインダクタL1とインダクタL2の結合方向を逆転させている。

30

【0005】

文献1に開示されたピーキング回路の回路図とその等価回路図を図12に示す。図12はバッファ回路にピーキング回路を用いた例を示している。バッファ回路は、トランジスタM5と、負荷抵抗R3と、電流源IS2とから構成される。インダクタL1, L2からなるピーキング回路は、負荷抵抗R3とトランジスタM5のドレインとの間に挿入され、インダクタL1とインダクタL2との接続点がバッファの出力端子OUTに接続されている。図12の右側の構成に示すように、縦列に接続されたインダクタL1, L2の接続形態をダブルシャント形態と呼ぶ。

【0006】

一方、図12の左側の構成は、このピーキング回路の等価回路を示している。すなわち、ダブルシャント形態のインダクタL1, L2から構成されるピーキング回路は、ダブルシャント形態のインダクタL1eff, L2effと、このインダクタL1eff, L2effの接続点と出力端子OUTとの間に挿入されたインダクタL3effとから構成されるピーキング回路と等価となる。インダクタL3effは、インダクタL1とインダクタL2との誘導結合によって等価的に形成されるインダクタである。このインダクタL3effのように回路の出力ノードと回路とを結ぶインダクタの接続形態をシリーズ形態と呼ぶ。

40

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

50

ピーキング回路においてダブルシャント形態に加えてシリーズ形態を用いると、半導体集積回路の周波数帯域を効果的に延伸することができる。文献1に開示されたピーキング回路では、シリーズ形態のインダクタ L_{3eff} が等価的に形成されているが、このインダクタ L_{3eff} とダブルシャント形態のインダクタ L_{1eff} 、 L_{2eff} とは誘導結合を形成しているわけではないので、ダブルシャント形態とシリーズ形態とを誘導結合させた場合に比べて周波数帯域の延伸効果が制限されるという問題点があった。また、文献1に開示されたピーキング回路では、インダクタ L_{3eff} に関連する誘導結合を設計パラメータとして用いることができないため、ピーキング特性の設計が難しいという問題点があった。

【0008】

また、文献1では、ダブルシャント形態の2個のインダクタを1個のスパイラル内に巻き込む形態が開示されているが、3個以上のインダクタを巻く構成が開示されていない。このため、文献1に開示されたインダクタの構成を用いて、ダブルシャント形態とシリーズ形態とを誘導結合させて回路の周波数帯域を延伸しようとする、ダブルシャント形態とシリーズ形態とを別個に作製せざるを得ず、半導体集積回路の面積が増大するという問題点があった。特に、差動回路にピーキング回路を付与する場合、回路の正相側と逆相側のそれぞれにピーキング回路用のインダクタが必要になるので、回路の面積が著しく増大する。

【0009】

さらに、文献1に開示されたピーキング回路では、ダブルシャント形態とシリーズ形態との間の誘導結合の方向性を自由に選択することができないという問題点があった。

【0010】

本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、ピーキング回路を形成するのに要する面積を削減することができ、かつピーキング特性の設計の自由度を高めることができるインダクタを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0011】

本発明のインダクタは、インダクタ領域の外周にスパイラルの形状に形成され、始点が第1の端子と接続された第1のインダクタ配線と、この第1のインダクタ配線の終点を始点として前記インダクタ領域の内周にスパイラルの形状に形成され、終点が第2の端子と接続された第2のインダクタ配線と、前記第1のインダクタ配線と前記第2のインダクタ配線との接続点を始点として前記第1のインダクタ配線と前記第2のインダクタ配線とに挟まれる領域にスパイラルの形状に形成され、終点が第3の端子と接続された第3のインダクタ配線とを備えることを特徴とするものである。

【発明の効果】

【0012】

本発明によれば、3個のインダクタ配線を、1個のスパイラルの面積で形成することができるので、3個のインダクタを用いる帯域延伸効果の大きなピーキング回路を小面積で形成することができる。本発明では、ダブルシャント形態のインダクタとシリーズ形態のインダクタとを別個のインダクタ領域に設ける場合と比較して、ピーキング回路を形成するのに要するインダクタの面積を1/2に削減可能である。その結果、本発明では、高速動作する半導体集積回路を低コストで提供することができる。また、本発明では、各インダクタ配線の巻き方向および各インダクタ配線間の距離を設計時に変更することにより、各インダクタ配線間の結合係数および結合方向を自由に選択することができ、インダクタと容量との関係を調整可能となるので、ピーキング特性の設計の自由度を高めることができる。その結果、本発明では、従来のインダクタを用いる場合と比較して、ピーキング回路の帯域延伸効果を高めることができる。

【図面の簡単な説明】

【0013】

【図1】図1は、本発明の第1実施例に係るインダクタの平面図である。

10

20

30

40

50

【図 2】図 2 は、本発明の第 1 実施例に係るインダクタの断面図である。

【図 3】図 3 は、本発明の第 1 実施例に係るインダクタをピーキング回路として使用した C M L 回路の回路図である。

【図 4】図 4 は、本発明の第 2 実施例に係るインダクタの平面図である。

【図 5】図 5 は、本発明の第 2 実施例に係るインダクタの断面図である。

【図 6】図 6 は、本発明の第 2 実施例に係るインダクタをピーキング回路として使用した C M L 回路の回路図である。

【図 7】図 7 は、本発明の第 1 実施例および第 2 実施例に係るインダクタによる面積の削減効果を説明する図である。

【図 8】図 8 は、本発明の第 2 実施例に係るインダクタによる帯域延伸効果を説明する図である。 10

【図 9】図 9 は、本発明の第 2 実施例に係るインダクタによる帯域延伸効果を説明する図である。

【図 10】図 10 は、従来のインダクタを用いた C M L 回路および本発明の第 2 実施例に係るインダクタを用いた C M L 回路の群遅延を示す図である。

【図 11 A - 11 B】図 11 A - 図 11 B は、従来のダブルシャント形態のインダクタの平面図である。

【図 11 C - 11 D】図 11 C - 図 11 D は、従来のダブルシャント形態のインダクタの等価回路図である。

【図 12】図 12 は、ダブルシャント形態のインダクタを使用したピーキング回路とその等価回路とを示す回路図である。 20

【発明を実施するための形態】

【0014】

[第 1 実施例]

以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図 1 は本発明の第 1 実施例に係るインダクタの平面図、図 2 は図 1 のインダクタの A - A 線断面図である。なお、図 1 では、複数の金属配線層を透視して記している。図 1 において、本実施例のインダクタ 1 は、第 1 のシャントインダクタ L 1 1 P (第 1 のインダクタ配線)と、第 2 のシャントインダクタ L 1 2 P (第 2 のインダクタ配線)と、第 1 のシリーズインダクタ L 1 3 P (第 3 のインダクタ配線)とからなる。 30

【0015】

以下、インダクタ L 1 1 P , L 1 2 P , L 1 3 P が形成される矩形または円形の領域をインダクタ領域と呼ぶ。図 1 の例では、点線で示す領域がインダクタ領域となる。

第 1 のシャントインダクタ L 1 1 P は、第 1 の金属配線層 3 0 を用いて形成され、インダクタ領域の最外周を平面視時計回りに 1 周するようにスパイラル状に形成される。第 1 のシャントインダクタ L 1 1 P の始点は端子 N 1 1 P と接続される。

【0016】

第 2 のシャントインダクタ L 1 2 P は、第 1 の金属配線層 3 0 を用いて形成され、第 1 のシャントインダクタ L 1 1 P の終点を始点としてインダクタ領域の最内周を平面視時計回りに 3 分の 4 周するようにスパイラル状に形成される。第 2 のシャントインダクタ L 1 2 P の終点は端子 N 1 2 P と接続される。 40

【0017】

ただし、第 2 のシャントインダクタ L 1 2 P は、端子 N 1 2 P へ至る途中で第 1 のシャントインダクタ L 1 1 P および第 1 のシリーズインダクタ L 1 3 P と交差するので、コンタクト (ピアホール) 1 0 によって第 2 の金属配線層 3 1 と接続され、以後は第 2 の金属配線層 3 1 を用いて端子 N 1 2 P と接続するように形成される。これにより、第 1 のシャントインダクタ L 1 1 P および第 1 のシリーズインダクタ L 1 3 P と接触することなく、第 2 のシャントインダクタ L 1 2 P を端子 N 1 2 P と接続することができる。

【0018】

第 1 のシリーズインダクタ L 1 3 P は、第 1 の金属配線層 3 0 を用いて形成され、第 1 50

のシャントインダクタL11Pと第2のシャントインダクタL12Pとの接続点11を始点として第1のシャントインダクタL11Pと第2のシャントインダクタL12Pに挟まれる円周上を平面視反時計回りに2分の1周するようにスパイラル状に形成される。すなわち、第1のシリーズインダクタL13Pは、第1のシャントインダクタL11Pの内側に沿って第1のシャントインダクタL11Pと逆巻きに形成される。第1のシリーズインダクタL13Pの終点は端子N13Pと接続される。

【0019】

ただし、第1のシリーズインダクタL13Pは、端子N13Pへ至る途中で第1のシャントインダクタL11Pと交差するので、コンタクト12によって第2の金属配線層31と接続され、以後は第2の金属配線層31を用いて端子N13Pと接続するように形成される。これにより、第1のシャントインダクタL11Pと接触することなく、第1のシリーズインダクタL13Pを端子N13Pと接続することができる。

10

【0020】

第1の金属配線層30と第2の金属配線層31との間は、図2に示すように絶縁層13によって絶縁される。こうして、2層の金属配線層30, 31と絶縁層13とによってインダクタ1を製作することができる。これらの金属配線層30, 31および絶縁層13は、図示しない半導体基板上に形成されている。

【0021】

第2のシャントインダクタL12Pの始点から終点への巻き方向は、第1のシャントインダクタL11Pの始点から終点への巻き方向と同方向でもよいし、逆方向でもよい。同様に、第1のシリーズインダクタL13Pの始点から終点への巻き方向は、第1のシャントインダクタL11Pの始点から終点への巻き方向と同方向でもよいし、逆方向でもよい。ただし、回路の帯域を延伸しようとする場合には、第1のシャントインダクタL11Pと第1のシリーズインダクタL13Pを逆方向に結合することにより、第1のシリーズインダクタL13Pによる共振周波数をピーキングゲインの増加を抑えて高周波側に設定できる効果をもたらす。

20

【0022】

また、本実施例では、第1の金属配線層と第2の金属配線層を用いた例を示しているが、より多くの配線層を使用して、金属配線層の上下を重ねるように構成すること、金属配線層の抵抗値を減ずることは、容易に類推可能である。

30

【0023】

図1、図2に示した本実施例のインダクタ1をピーキング回路として使用したCML (Current Mode Logic) 回路を図3に示す。CML回路は、ゲートが正相入力端子INPに接続されたMOSトランジスタM1と、ゲートが逆相入力端子INNに接続されたMOSトランジスタM2と、ゲートが電源VDDに接続され、ソースがMOSトランジスタM1のドレインに接続されたMOSトランジスタM3と、ゲートが電源VDDに接続され、ソースがMOSトランジスタM2のドレインに接続されたMOSトランジスタM4と、アノード端子がMOSトランジスタM1, M2のソースに共通に接続され、カソードが接地された電流源IS1と、端子N11PがMOSトランジスタM3のドレインに接続され、端子N13PがCML回路の出力端子OUTPUTに接続されたインダクタ1と、端子N11NがMOSトランジスタM4のドレインに接続され、端子N13NがCML回路の出力端子OUTNに接続されたインダクタ1aと、一端が電源VDDに接続され、他端がインダクタ1の端子N12Pに接続された負荷抵抗R1と、一端が電源VDDに接続され、他端がインダクタ1aの端子N12Nに接続された負荷抵抗R2とから構成される。

40

【0024】

正相側のインダクタ1の構成は、図1、図2に示したとおりである。逆相側のインダクタ1aもインダクタ1と同様の構成である。すなわち、インダクタ1aは、インダクタ1のL11P, L12P, L13P, N11P, N12P, N13Pを、それぞれL11N, L12N, L13N, N11N, N12N, N13Nに置き換えたものに相当するので、詳細な説明は省略する。

50

【 0 0 2 5 】

図 3 における K_{112P} は第 1 のシャントインダクタ L_{11P} と第 2 のシャントインダクタ L_{12P} との間の結合係数、 K_{131P} は第 1 のシャントインダクタ L_{11P} と第 1 のシリーズインダクタ L_{13P} との間の結合係数、 K_{123P} は第 2 のシャントインダクタ L_{12P} と第 1 のシリーズインダクタ L_{13P} との間の結合係数である。同様に、 K_{112N} は第 1 のシャントインダクタ L_{11N} と第 2 のシャントインダクタ L_{12N} との間の結合係数、 K_{131N} は第 1 のシャントインダクタ L_{11N} と第 1 のシリーズインダクタ L_{13N} との間の結合係数、 K_{123N} は第 2 のシャントインダクタ L_{12N} と第 1 のシリーズインダクタ L_{13N} との間の結合係数である。

【 0 0 2 6 】

本実施例のインダクタ 1, 1a を使用した CML 回路の動作を説明する。CML 回路の正相入力端子 INP と逆相入力端子 INN には差動信号が入力される。出力端子 $OUTP$ と $OUTN$ には、負荷容量 (不図示) が接続される。この負荷容量は、CML 回路の後段に接続される回路のトランジスタなどに起因する寄生容量成分である。CML 回路は、差動入力信号を所望のゲインで増幅することが求められる。そして、所望のゲインを、所望の高い周波数帯域まで平坦に得ることが理想となる。

【 0 0 2 7 】

CML 回路の出力端子 $OUTP$ から出力される出力電圧の振幅は、DC 的には抵抗 R_1 の値と電流源 IS_1 を流れる電流 I との積で決定される。同様に、出力端子 $OUTN$ から出力される出力電圧の振幅は、DC 的には抵抗 R_2 の値と電流 I との積で決定される。入力電圧振幅に対する出力電圧振幅の比が CML 回路のゲインとなる。

【 0 0 2 8 】

以下、正相側について CML 回路の高周波動作を説明する。インダクタ 1 をインダクタンスのない配線と仮定すると、出力端子 $OUTP$ に付加される負荷容量に端子 N_{11P} , N_{12P} の寄生容量を加えた全容量 C と、負荷抵抗 R_1 とによって決まる時定数 $R_1 \times C$ により、CML 回路の正相側の -3 dB 帯域が決定される。したがって、全容量 C が大きいと、CML 回路の周波数帯域は低くなってしまふ。

【 0 0 2 9 】

一方、本実施例では、出力端子 $OUTP$ に付加される負荷容量をインダクタ 1 の第 1 のシリーズインダクタ L_{13P} によって CML 回路から高周波的に切り離す。また、端子 N_{11P} の寄生容量は、第 1 のシャントインダクタ L_{11P} によって CML 回路から高周波的に切り離され、端子 N_{12P} の寄生容量は、第 2 のシャントインダクタ L_{12P} によって CML 回路から高周波的に切り離される。

【 0 0 3 0 】

したがって、CML 回路の出力電圧の応答は、端子 N_{11P} の寄生容量と第 1 のシャントインダクタ L_{11P} とから構成される共振回路の高周波の極 (共振周波数) と、端子 N_{12P} の寄生容量と第 2 のシャントインダクタ L_{12P} とから構成される共振回路の高周波の極と、出力端子 $OUTP$ に付加される負荷容量と第 1 のシリーズインダクタ L_{13P} とから構成される共振回路の高周波の極のそれぞれによって決定される。CML 回路の逆相側の高周波動作は、出力端子 $OUTP$ とインダクタ 1 に関する記述を、出力端子 $OUTN$ とインダクタ 1a に関する記述に置き換えればよいので、説明は省略する。

【 0 0 3 1 】

以上のようにして、本実施例では、インダクタ L_{11P} , L_{12P} , L_{13P} からなるピーキング回路およびインダクタ L_{11N} , L_{12N} , L_{13N} からなるピーキング回路によって CML 回路の周波数帯域を延伸することができる。本実施例では、3 個のインダクタを、1 個のインダクタスパイラルの面積で形成することができるので、3 個のインダクタを用いる帯域延伸効果の大きなピーキング回路を小面積で形成することができる。本実施例では、ダブルシャント形態のインダクタとシリーズ形態のインダクタとを別個のインダクタ領域に設ける場合と比較して、ピーキング回路を形成するのに要するインダクタの面積を $1/2$ に削減可能である。その結果、本実施例では、高速動作する半導体集積回路

10

20

30

40

50

を低コストで提供することができる。

【0032】

また、文献1に開示された従来のインダクタでは、インダクタ L_{3eff} に関連する誘導結合を設計パラメータとして用いることができず、ダブルシャント形態とシリーズ形態との間の誘導結合の方向性を自由に選択することができないので、ピーキング回路を構成する各容量と各インダクタの値を、所望のピーキング量とピーキング周波数に合わせ込む自由度が少ないという問題点があった。文献1に開示された従来のインダクタでは、低周波側にピーキング周波数を設定しようとする、インダクタ値を大きく設定しなければならないためにピーキング量が大きくなり過ぎる。逆に、ピーキング量を抑えようとしてインダクタ値を小さくすると、ピーキング周波数が高くなり過ぎて、所望の平坦な帯域延伸を得にくくなる。

10

【0033】

これに対して、本実施例では、各インダクタの巻き方向および各インダクタ間の距離を設計時に変更することにより、第1、第2のシャントインダクタ L_{11P} 、 L_{12P} と第1のシリーズインダクタ L_{13P} との間の結合係数 K_{131P} 、 K_{123P} および結合方向を自由に選択することができ、インダクタと容量との関係を調整可能となるので、ピーキング特性の設計の自由度を高めることができる。同様に、逆相側についても、第1、第2のシャントインダクタ L_{11N} 、 L_{12N} と第1のシリーズインダクタ L_{13N} との間の結合係数 K_{131N} 、 K_{123N} および結合方向を自由に選択することができる。本実施例では、ピーキング特性の設計の自由度を高めることにより、より一層の帯域延伸効果を得ることができる。

20

【0034】

また、本実施例では、ピーキング回路のシリーズ形態のインダクタとなる第1のシリーズインダクタ L_{13P} を、ピーキング回路のダブルシャント形態のインダクタとなる第1のシャントインダクタ L_{11P} と逆巻きに形成する。第1のシリーズインダクタ L_{13P} を第1のシャントインダクタ L_{11P} と逆巻きに形成すると、結合方向の選択の自由度が制限されることになるが、ピーキング回路の帯域延伸効果を更に高めることができる。特に、逆巻きに形成することにより第1のシリーズインダクタ L_{13P} と第1のシャントインダクタ L_{11P} との誘導結合が、端子 N_{13P} に接続される負荷の容量と第1のシリーズインダクタ L_{13P} とで形成される共振周波数を高周波側に移す作用を生み出す。この作用は、第1のシリーズインダクタ L_{13P} の自己インダクタンスを単純に減じて得られる作用とは異なる。

30

【0035】

また、本実施例では、各インダクタ配線を、第1の金属配線層を用いて形成し、他のインダクタ配線と交差する箇所のみコンタクトを介して第2の金属配線層に退避するように形成したことにより、2層の金属配線層によって複数個のインダクタを製作することができる。本実施例では、インダクタを構成するのに必要な層数を抑えることができるので、複数個のインダクタを用いたピーキング回路を搭載する半導体集積回路を、低コストで提供することができる。

40

【0036】

なお、図1から明らかなように、第1のシリーズインダクタ L_{13P} には、第1のシャントインダクタ L_{11P} の内周と第2のシャントインダクタ L_{12P} の内周とに挟まれる領域に形成される部分と、第1のシャントインダクタ L_{11P} の内周と第2のシャントインダクタ L_{12P} の外周とに挟まれる領域に形成される部分とが存在する。これら2つの領域のどちらに第1のシリーズインダクタ L_{13P} が形成されていても構わない。第1のシャントインダクタ L_{11P} と第1のシリーズインダクタ L_{13P} の隣接した配置と巻き込み方向が相互インダクタンスの値と正負を決定する。

【0037】

[第2実施例]

次に、第2実施例について説明する。図4は本発明の第2実施例に係るインダクタの平

50

面図、図5は図4のインダクタのB-B線断面図である。なお、図4では、複数の金属配線層を透視して記している。本実施例は、差動回路の正相側に用いる3個のインダクタと逆相側に用いる3個のインダクタとを1個のスパイラル内に巻き込んだものである。図4において、本実施例のインダクタ2は、正相側の第1のシャントインダクタL11P（第1のインダクタ配線）と、正相側の第2のシャントインダクタL12P（第2のインダクタ配線）と、正相側の第1のシリーズインダクタL13P（第3のインダクタ配線）と、逆相側の第1のシャントインダクタL11N（第4のインダクタ配線）と、逆相側の第2のシャントインダクタL12N（第5のインダクタ配線）と、逆相側の第1のシリーズインダクタL13N（第6のインダクタ配線）とからなる。図1と同様に、図4では点線で示す領域がインダクタ領域となる。

10

【0038】

正相側の第1のシャントインダクタL11Pは、第1の金属配線層30を用いて形成され、インダクタ領域の外周を平面視時計回りに1周するようにスパイラル状に形成される。正相側の第1のシャントインダクタL11Pの始点は端子N11Pと接続される。

【0039】

正相側の第2のシャントインダクタL12Pは、第1の金属配線層30を用いて形成され、正相側の第1のシャントインダクタL11Pの終点を始点としてインダクタ領域の内周を平面視時計回りに3分の4周するようにスパイラル状に形成される。正相側の第2のシャントインダクタL12Pの終点は端子N12Pと接続される。

20

【0040】

ただし、正相側の第2のシャントインダクタL12Pは、端子N12Pへ至る途中で正相側の第1のシャントインダクタL11P、正相側の第1のシリーズインダクタL13P、逆相側の第1のシャントインダクタL11Nおよび逆相側の第2のシャントインダクタL12Nと交差するので、コンタクト（ピアホール）10によって第2の金属配線層31と接続され、以後は第2の金属配線層31を用いて端子N12Pと接続するように形成される。これにより、正相側の第1のシャントインダクタL11P、正相側の第1のシリーズインダクタL13P、逆相側の第1のシャントインダクタL11Nおよび逆相側の第2のシャントインダクタL12Nと接触することなく、正相側の第2のシャントインダクタL12Pを端子N12Pと接続することができる。

【0041】

正相側の第1のシリーズインダクタL13Pは、第1の金属配線層30を用いて形成され、正相側の第1のシャントインダクタL11Pと正相側の第2のシャントインダクタL12Pとの接続点11を始点として正相側の第1のシャントインダクタL11Pと正相側の第2のシャントインダクタL12Pに挟まれる円周上を平面視反時計回りに2分の1周するようにスパイラル状に形成される。すなわち、正相側の第1のシリーズインダクタL13Pは、正相側の第1のシャントインダクタL11Pの内側に沿って正相側の第1のシャントインダクタL11Pと逆巻きに形成される。正相側の第1のシリーズインダクタL13Pの終点は端子N13Pと接続される。

30

【0042】

ただし、正相側の第1のシリーズインダクタL13Pは、端子N13Pへ至る途中で正相側の第1のシャントインダクタL11Pおよび逆相側の第1のシャントインダクタL11Nと交差するので、コンタクト12によって第2の金属配線層31と接続され、以後は第2の金属配線層31を用いて端子N13Pと接続するように形成される。これにより、正相側の第1のシャントインダクタL11Pおよび逆相側の第1のシャントインダクタL11Nと接触することなく、正相側の第1のシリーズインダクタL13Pを端子N13Pと接続することができる。

40

【0043】

逆相側の第1のシャントインダクタL11Nは、第1の金属配線層30を用いて形成され、インダクタ領域の外周を平面視反時計回りに1周するようにスパイラル状に形成される。逆相側の第1のシャントインダクタL11Nの始点は端子N11Nと接続される。

50

【 0 0 4 4 】

ただし、逆相側の第1のシャントインダクタL11Nは、始点から終点へ至る途中で正相側の第1のシャントインダクタL11Pと交差するので、コンタクト14によって第2の金属配線層31と接続され、正相側の第1のシャントインダクタL11Pとの交差が終わるコンタクト15の位置まで第2の金属配線層31を用いて形成される。そして、逆相側の第1のシャントインダクタL11Nは、コンタクト15によって第1の金属配線層30と接続され、以後は終点の位置まで第1の金属配線層30を用いて形成される。これにより、正相側の第1のシャントインダクタL11Pと接触することなく、逆相側の第1のシャントインダクタL11Nを形成することができる。

【 0 0 4 5 】

逆相側の第2のシャントインダクタL12Nは、第1の金属配線層30を用いて形成され、逆相側の第1のシャントインダクタL11Nの終点を始点としてインダクタ領域の内周を平面視反時計回りに3分の4周するようにスパイラル状に形成される。逆相側の第2のシャントインダクタL12Nの終点は端子N12Nと接続される。

【 0 0 4 6 】

ただし、逆相側の第2のシャントインダクタL12Nは、始点から端子N12Nへ至る途中で正相側の第2のシャントインダクタL12Pと交差するので、コンタクト16によって第2の金属配線層31と接続され、正相側の第2のシャントインダクタL12Pとの交差が終わるコンタクト17の位置まで第2の金属配線層31を用いて形成される。そして、逆相側の第2のシャントインダクタL12Nは、コンタクト17によって第1の金属配線層30と接続される。

【 0 0 4 7 】

この第1の金属配線層30を用いて形成された逆相側の第2のシャントインダクタL12Nは、再び正相側の第2のシャントインダクタL12Pと交差するので、コンタクト18によって第2の金属配線層31と接続され、正相側の第2のシャントインダクタL12Pとの交差が終わるコンタクト19の位置まで第2の金属配線層31を用いて形成される。そして、逆相側の第2のシャントインダクタL12Nは、コンタクト19によって第1の金属配線層30と接続される。

【 0 0 4 8 】

さらに、逆相側の第2のシャントインダクタL12Nは、正相側の第1のシャントインダクタL11P、正相側の第2のシャントインダクタL12P、逆相側の第1のシャントインダクタL11Nおよび逆相側の第1のシリーズインダクタL13Nと交差するので、コンタクト20によって第2の金属配線層31と接続され、以後は第2の金属配線層31を用いて端子N12Nと接続するように形成される。こうして、正相側の第1のシャントインダクタL11P、正相側の第2のシャントインダクタL12P、逆相側の第1のシャントインダクタL11Nおよび逆相側の第1のシリーズインダクタL13Nと接触することなく、逆相側の第2のシャントインダクタL12Nを端子N12Nと接続することができる。

【 0 0 4 9 】

逆相側の第1のシリーズインダクタL13Nは、第1の金属配線層30を用いて形成され、逆相側の第1のシャントインダクタL11Nと逆相側の第2のシャントインダクタL12Nとの接続点であるコンタクト16の位置を始点として逆相側の第1のシャントインダクタL11Nと逆相側の第2のシャントインダクタL12Nに挟まれる円周上を平面視時計回りに2分の1周するようにスパイラル状に形成される。すなわち、逆相側の第1のシリーズインダクタL13Nは、逆相側の第1のシャントインダクタL11Nの内側に沿って逆相側の第1のシャントインダクタL11Nと逆巻きに形成される。逆相側の第1のシリーズインダクタL13Nの終点は端子N13Nと接続される。

【 0 0 5 0 】

ただし、逆相側の第1のシリーズインダクタL13Nは、端子N13Nへ至る途中で正相側の第1のシャントインダクタL11Pおよび逆相側の第1のシャントインダクタL1

10

20

30

40

50

1 Nと交差するので、コンタクト 2 1によって第 2の金属配線層 3 1と接続され、以後は第 2の金属配線層 3 1を用いて端子 N 1 3 Nと接続するように形成される。これにより、正相側の第 1のシャントインダクタ L 1 1 Pおよび逆相側の第 1のシャントインダクタ L 1 1 Nと接触することなく、逆相側の第 1のシリーズインダクタ L 1 3 Nを端子 N 1 3 Nと接続することができる。

【 0 0 5 1 】

第 1実施例と同様に、第 1の金属配線層 3 0と第 2の金属配線層 3 1との間は、図 5に示すように絶縁層 1 3によって絶縁される。こうして、2層の金属配線層 3 0, 3 1と絶縁層 1 3とによってインダクタ 2を製作することができる。これらの金属配線層 3 0, 3 1および絶縁層 1 3は、図示しない半導体基板上に形成されている。

10

【 0 0 5 2 】

正相側の第 2のシャントインダクタ L 1 2 Pの始点から終点への巻き方向は、正相側の第 1のシャントインダクタ L 1 1 Pの始点から終点への巻き方向と同方向でもよいし、逆方向でもよい。正相側の第 1のシリーズインダクタ L 1 3 Pの始点から終点への巻き方向は、正相側の第 1のシャントインダクタ L 1 1 Pの始点から終点への巻き方向と同方向でもよいし、逆方向でもよい。また、逆相側の第 2のシャントインダクタ L 1 2 Nの始点から終点への巻き方向は、逆相側の第 1のシャントインダクタ L 1 1 Nの始点から終点への巻き方向と同方向でもよいし、逆方向でもよい。逆相側の第 1のシリーズインダクタ L 1 3 Nの始点から終点への巻き方向は、逆相側の第 1のシャントインダクタ L 1 1 Nの始点から終点への巻き方向と同方向でもよいし、逆方向でもよい。

20

【 0 0 5 3 】

図 4に示すように、インダクタ 2において、逆相側の第 1のシャントインダクタ L 1 1 Nは、正相側および逆相側のインダクタ L 1 1 P, L 1 2 P, L 1 3 P, L 1 1 N, L 1 2 N, L 1 3 Nのスパイラルの中心 2 2を通る直線であって且つこのスパイラルが形成された平面と平行な直線 2 3に関して、正相側の第 1のシャントインダクタ L 1 1 Pと線対称に形成される。逆相側の第 2のシャントインダクタ L 1 2 Nは、直線 2 3に関して正相側の第 2のシャントインダクタ L 1 2 Pと線対称に形成される。逆相側の第 1のシリーズインダクタ L 1 3 Nは、直線 2 3に関して正相側の第 1のシリーズインダクタ L 1 3 Pと線対称に形成される。このように、本実施例では、正相側のインダクタ L 1 1 P, L 1 2 P, L 1 3 Pと逆相側のインダクタ L 1 1 N, L 1 2 N, L 1 3 Nとを線対称に配置することにより、差動信号用のピーキング回路に必要な 6個のインダクタを少ない層数で集積するのに最適なレイアウトを実現することができる。なお、正相側のインダクタ L 1 1 P, L 1 2 P, L 1 3 Pと逆相側のインダクタ L 1 1 N, L 1 2 N, L 1 3 Nとを線対称に配置することにより、相互コンダクタンスも大きく得られる。相互コンダクタンスが多少小さくなくても良い場合は、回路レイアウトの都合に合わせて、例えば正相側のインダクタ L 1 1 P, L 1 2 P, L 1 3 P、もしくは逆相側のインダクタ L 1 1 N, L 1 2 N, L 1 3 Nを、スパイラルの中心 2 2がズレないように数度から 4 5 度程度まで回転させて配置しても良い。

30

【 0 0 5 4 】

図 4、図 5に示したインダクタ 2をピーキング回路として使用した C M L回路を図 6に示す。C M L回路は、ゲートが正相入力端子 I N Pに接続された M O Sトランジスタ M 1と、ゲートが逆相入力端子 I N Nに接続された M O Sトランジスタ M 2と、ゲートが電源 V D Dに接続され、ソースが M O Sトランジスタ M 1のドレインに接続された M O Sトランジスタ M 3と、ゲートが電源 V D Dに接続され、ソースが M O Sトランジスタ M 2のドレインに接続された M O Sトランジスタ M 4と、アノード端子が M O Sトランジスタ M 1, M 2のソースに共通に接続され、カソードが接地された電流源 I S 1と、端子 N 1 1 Pが M O Sトランジスタ M 3のドレインに接続され、端子 N 1 1 Nが M O Sトランジスタ M 4のドレインに接続され、端子 N 1 3 Pが C M L回路の出力端子 O U T Pに接続され、端子 N 1 3 Nが C M L回路の出力端子 O U T Nに接続されたインダクタ 2と、一端が電源 V D Dに接続され、他端がインダクタ 2の端子 N 1 2 Pに接続された負荷抵抗 R 1と、一端

40

50

が電源 V D D に接続され、他端がインダクタ 2 の端子 N 1 2 N に接続された負荷抵抗 R 2 とから構成される。

【 0 0 5 5 】

本実施例のインダクタ 2 を使用した C M L 回路の動作を説明する。C M L 回路の正相入力端子 I N P と逆相入力端子 I N N には差動信号が入力される。出力端子 O U T P と O U T N には、負荷容量（不図示）が接続される。第 1 実施例で説明したとおり、この負荷容量は、C M L 回路の後段に接続される回路のトランジスタなどに起因する寄生容量成分である。C M L 回路は、差動入力信号を所望のゲインで増幅することが求められる。そして、所望のゲインを、所望の高い周波数帯域まで平坦に得ることが理想となる。

【 0 0 5 6 】

C M L 回路の出力端子 O U T P から出力される出力電圧の振幅は、D C 的には抵抗 R 1 の値と電流源 I S 1 を流れる電流 I との積で決定される。同様に、出力端子 O U T N から出力される出力電圧の振幅は、D C 的には抵抗 R 2 の値と電流 I との積で決定される。入力電圧振幅に対する出力電圧振幅の比が C M L 回路のゲインとなる。

【 0 0 5 7 】

以下、正相側について C M L 回路の高周波動作を説明する。インダクタ 2 をインダクタンスのない配線と仮定すると、出力端子 O U T P に付加される負荷容量に端子 N 1 1 P , N 1 2 P の寄生容量を加えた全容量 C と、負荷抵抗 R 1 とによって決まる時定数 $R 1 \times C$ により、C M L 回路の正相側の - 3 d B 帯域が決定される。したがって、全容量 C が大きいと、C M L 回路の周波数帯域は低くなってしまふ。

【 0 0 5 8 】

一方、本実施例では、出力端子 O U T P に付加される負荷容量をインダクタ 2 の正相側の第 1 のシリーズインダクタ L 1 3 P によって C M L 回路から高周波的に切り離す。また、端子 N 1 1 P の寄生容量は、正相側の第 1 のシャントインダクタ L 1 1 P によって C M L 回路から高周波的に切り離され、端子 N 1 2 P の寄生容量は、正相側の第 2 のシャントインダクタ L 1 2 P によって C M L 回路から高周波的に切り離される。

【 0 0 5 9 】

したがって、C M L 回路の出力電圧の応答は、端子 N 1 1 P の寄生容量と正相側の第 1 のシャントインダクタ L 1 1 P とから構成される共振回路の高周波の極（共振周波数）と、端子 N 1 2 P の寄生容量と正相側の第 2 のシャントインダクタ L 1 2 P とから構成される共振回路の高周波の極と、出力端子 O U T P に付加される負荷容量と正相側の第 1 のシリーズインダクタ L 1 3 P とから構成される共振回路の高周波の極のそれぞれによって決定される。C M L 回路の逆相側の高周波動作は、出力端子 O U T P と正相側のインダクタ L 1 1 P , L 1 2 P , L 1 3 P に関する記述を、出力端子 O U T N と逆相側のインダクタ L 1 1 N , L 1 2 N , L 1 3 N に関する記述に置き換えればよいので、説明は省略する。

【 0 0 6 0 】

以上のようにして、本実施例では、正相側のインダクタ L 1 1 P , L 1 2 P , L 1 3 からなるピーキング回路および逆相側のインダクタ L 1 1 N , L 1 2 N , L 1 3 N からなるピーキング回路によって C M L 回路の周波数帯域を延伸することができる。本実施例では、正相側の 3 個のインダクタと逆相側の 3 個のインダクタとを、1 個のインダクタスパイラルの面積で形成することができるので、正相側と逆相側に 3 個ずつインダクタを用いる帯域延伸効果の大きなピーキング回路を小面積で形成することができる。本実施例では、ダブルシャント形態のインダクタとシリーズ形態のインダクタとを別個のインダクタ領域に設ける場合と比較して、ピーキング回路を形成するのに要するインダクタの面積を 1 / 4 に削減可能であり、正相側のインダクタと逆相側のインダクタを別個に形成する第 1 実施例と比較して、インダクタの形成に要する面積を 2 分の 1 に削減可能である。その結果、本実施例では、高速動作する差動構成の半導体集積回路を低コストで提供することができる。

【 0 0 6 1 】

文献 1 に開示された従来のインダクタでは、インダクタ L 3 e f f に関連する誘導結合

10

20

30

40

50

を設計パラメータとして用いることができず、ダブルシャント形態とシリーズ形態との間の誘導結合の方向性を自由に選択することができないので、ピーキング回路を構成する各容量と各インダクタの値を、所望のピーキング量とピーキング周波数に合わせ込む自由度が少ない。

【0062】

これに対して、本実施例では、各インダクタを隣接させる順番、各インダクタの巻き方向および各インダクタ間の距離を設計時に変更することにより、正相側の第1、第2のシャントインダクタ L_{11P} 、 L_{12P} と正相側の第1のシリーズインダクタ L_{13P} との間の結合係数 K_{131P} 、 K_{123P} および結合方向を自由に選択することができ、インダクタと容量との関係を調整可能となるので、ピーキング特性の設計の自由度を高めることができる。同様に、逆相側についても、逆相側の第1、第2のシャントインダクタ L_{11N} 、 L_{12N} と逆相側の第1のシリーズインダクタ L_{13N} との間の結合係数 K_{131N} 、 K_{123N} および結合方向を自由に選択することができる。本実施例では、ピーキング特性の設計の自由度を高めることにより、より一層の帯域延伸効果を得ることができる。さらに、本実施例では、正相側のインダクタ群と逆相側のインダクタ群とを強く誘導結合させることができる。その結果、本実施例では、従来のインダクタを用いる場合と比較して、ピーキング回路の帯域延伸効果を高めることができる。

10

【0063】

また、本実施例では、ピーキング回路のシリーズ形態のインダクタとなる逆相側の第1のシリーズインダクタ L_{13N} を、ピーキング回路のダブルシャント形態のインダクタとなる逆相側の第1のシャントインダクタ L_{11N} と逆巻きに形成する。逆相側の第1のシリーズインダクタ L_{13N} を逆相側の第1のシャントインダクタ L_{11N} と逆巻きに形成すると、結合方向の選択の自由度が制限されることになるが、ピーキング回路の帯域延伸効果を更に高めることができる。

20

【0064】

また、本実施例では、各インダクタ配線を、第1の金属配線層を用いて形成し、他のインダクタ配線と交差する箇所のみコンタクトを介して第2の金属配線層に退避するように形成したことにより、2層の金属配線層によって複数個のインダクタを製作することができる。本実施例では、インダクタを構成するのに必要な層数を抑えることができるので、複数個のインダクタを用いたピーキング回路を搭載する半導体集積回路を、低コストで提供することができる。

30

【0065】

図7を用いて、第1実施例と第2実施例によるインダクタ面積の削減効果を説明する。図7では、図3に示したような差動構成のピーキング回路を形成するインダクタの面積を示している。また、図7では、第2実施例のインダクタ2の面積を1として面積を正規化している。以下、このインダクタ2の1個分の領域をインダクタ領域と呼ぶ。図7において、700は第1実施例のインダクタ1、1aの合計の面積を示し、701は第2実施例のインダクタ2の面積を示し、702は文献1に開示された従来のインダクタを正相側と逆相側にそれぞれに設けた合計の面積を示し、703は従来のインダクタに更に正相側と逆相側のシリーズインダクタを別個に加えた合計の面積を示している。

40

【0066】

文献1に開示された従来のインダクタによると、ダブルシャント形態は1個のインダクタ領域に形成される。このダブルシャント形態のインダクタにシリーズ形態のインダクタを付加すると、正相側だけで2個のインダクタ領域が必要となるので、差動回路全体では図7の703で示すようにインダクタ領域4個分の面積を要する。また、図12で説明したようにダブルシャント形態で等価的にシリーズ形態のインダクタを形成すると、図7の702で示すように2個のインダクタ領域を削減可能であるが、ダブルシャント形態のインダクタとシリーズ形態のインダクタとの間の誘導結合を、帯域延伸に寄与するように作り出すことはできない。

【0067】

50

これに対して、第1実施例によると、ダブルシャント形態のインダクタとシリーズ形態のインダクタとの間の誘導結合を利用可能なピーキング回路を2個のインダクタ領域で形成可能である。さらに、第2実施例によると、差動構成のピーキング回路を1個のインダクタ領域で形成可能である。

【0068】

次に、図8を用いて、従来のインダクタと第2実施例のインダクタによる帯域延伸効果を説明する。図8において、800は文献1に開示された従来のインダクタを用いたCML回路の周波数特性を示し、801は第2実施例のインダクタ2を用いたCML回路の周波数特性を示している。ここでは、 $0.18\ \mu\text{m}$ CMOSトランジスタを用いてCML回路を形成し、CML回路の負荷として2倍の大きさの回路を接続して、シミュレーションによりCML回路のゲインを計算した。

10

【0069】

従来のインダクタを用いたCML回路では、図6におけるインダクタ L_{11P} 、 L_{11N} を $0.335\ \text{nH}$ 、インダクタ L_{12P} 、 L_{12N} を $0.210\ \text{nH}$ 、インダクタ L_{13P} 、 L_{13N} を $0.225\ \text{nH}$ とし、各インダクタ間の結合係数 K_{112P} 、 K_{131P} 、 K_{123P} 、 K_{112N} 、 K_{131N} 、 K_{123N} は全て0とした。各インダクタの値はシミュレーションにより調整を行って、CML回路の周波数帯域が最も伸びる値に決定している。

【0070】

一方、第2実施例のインダクタ2を実際にレイアウトし、電磁界解析により抽出したインダクタンス値と結合係数とを用いてシミュレーションしたCML回路の周波数特性が図8の801に示す特性である。このとき、インダクタ L_{11P} 、 L_{11N} は $0.335\ \text{nH}$ 、インダクタ L_{12P} 、 L_{12N} は $0.110\ \text{nH}$ 、インダクタ L_{13P} 、 L_{13N} は $0.125\ \text{nH}$ である。

20

【0071】

また、インダクタ L_{11P} とインダクタ L_{12P} との間の結合係数 K_{112P} は 0.2 、インダクタ L_{11P} とインダクタ L_{13P} との間の結合係数 K_{131P} は -0.4 、インダクタ L_{11P} とインダクタ L_{11N} との間の結合係数は -0.67 、インダクタ L_{11P} とインダクタ L_{12N} との間の結合係数は -0.2 、インダクタ L_{11P} とインダクタ L_{13N} との間の結合係数は 0.33 である。

30

【0072】

また、インダクタ L_{12P} とインダクタ L_{11N} との間の結合係数は -0.2 、インダクタ L_{12P} とインダクタ L_{12N} との間の結合係数は -0.4 、インダクタ L_{12P} とインダクタ L_{13N} との間の結合係数は 0.34 、インダクタ L_{13P} とインダクタ L_{11N} との間の結合係数は 0.33 、インダクタ L_{13P} とインダクタ L_{12N} との間の結合係数は 0.34 、インダクタ L_{11N} とインダクタ L_{12N} との間の結合係数 K_{112N} は 0.2 、インダクタ L_{11N} とインダクタ L_{13N} との間の結合係数 K_{131N} は -0.4 である。結合係数の絶対値が 0.1 より小さい係数は0とした。

【0073】

図8によれば、第2実施例で実現されるインダクタ間の誘導相互結合により、従来のインダクタを用いたCML回路と比較して20%を超える帯域延伸効果が得られ、かつ平坦なゲイン特性が得られることが分かる。

40

【0074】

さらに、図9を用いて、第2実施例のインダクタによる帯域延伸効果を説明する。図9において、900は文献1に開示された従来のインダクタを用いたCML回路の $-3\ \text{dB}$ 帯域を示し、901は第2実施例のインダクタを用いたCML回路の $-3\ \text{dB}$ 帯域を示している。図9の例では、半導体集積回路の金属配線層でインダクタを作成した場合を仮定し、各インダクタに金属配線の寄生容量である対地容量を付加したときのCML回路の $-3\ \text{dB}$ 帯域を、シミュレーションにより計算した。従来のインダクタを用いたCML回路の各インダクタの値および結合係数の値、第2実施例のインダクタを用いたCML回路の

50

各インダクタの値および結合係数の値は、図 8 のシミュレーションで採用した値と同じである。

【 0 0 7 5 】

また、図 9 では、C M L 回路の各インダクタに寄生容量を付加した場合を配線寄生容量の倍率 “ 1 ” とし、寄生容量を 2 倍にして付加した場合を配線寄生容量の倍率 “ 2 ” とし、寄生容量を付加しない場合を配線寄生容量の倍率 “ 0 ” とし、それぞれの場合の C M L 回路の - 3 d B 帯域の計算値を示している。なお、従来のインダクタを用いた C M L 回路では、図 1 2 に示したように、インダクタ L 3 e f f が仮想的に形成されるため、インダクタ L 3 e f f のみ寄生容量は付加していない。

【 0 0 7 6 】

第 2 実施例のインダクタを用いた C M L 回路では、寄生容量により 1 . 5 G H z 程度帯域が低下するが、従来のインダクタを用いた C M L 回路においても寄生容量により 1 G H z 程度帯域が低下している。図 9 によれば、第 2 実施例のインダクタを用いた C M L 回路では、寄生容量の有無に拘わらず、従来のインダクタを用いた C M L 回路と比較して 2 0 % 程度の帯域延伸効果が得られることが分かる。

【 0 0 7 7 】

インダクタにつく寄生容量は、インダクタを形成する金属配線層と基板の間に形成される対地容量と、隣接する金属配線間に形成される線間容量に分けられる。対地容量は、使用する半導体プロセスや使用する金属配線層により変わる。また、線間容量は、隣接する金属配線層をどの程度近づけるかに依存する。上記の図 9 は、半導体基板とインダクタの金属配線間の距離が 1 μ m で、隣接する金属配線間の距離が 2 μ m、インダクタの金属配線の幅が 6 μ m の例を示している。半導体基板と金属配線間の距離が、金属配線間の距離より小さいため、インダクタに付加される寄生容量のほとんどを対地容量が占める。インダクタの金属配線として、半導体基板からの距離が遠くなる上層金属配線を使用すると、図 9 の配線寄生容量倍率 “ 0 ” ~ “ 1 ” で示した帯域延伸効果が得られる。また、金属配線間の距離が近くなり、上記の対地容量よりも線間容量が大きくなると、図 9 の配線寄生容量倍率 “ 1 ” ~ “ 2 ” で示した帯域延伸効果が得られる。

【 0 0 7 8 】

図 1 0 は、文献 1 に開示された従来のインダクタを用いた C M L 回路および第 2 実施例のインダクタを用いた C M L 回路の群遅延をシミュレーションにより求めた結果を示す図である。図 1 0 において、1 0 0 0 は従来のインダクタを用いた C M L 回路の配線寄生容量倍率 “ 0 ” の場合の群遅延を示し、1 0 0 0 a は従来のインダクタを用いた C M L 回路の配線寄生容量倍率 “ 1 ” の場合の群遅延を示し、1 0 0 1 は第 2 実施例のインダクタを用いた C M L 回路の配線寄生容量倍率 “ 0 ” の場合の群遅延を示し、1 0 0 1 a は第 2 実施例のインダクタを用いた C M L 回路の配線寄生容量倍率 “ 1 ” の場合の群遅延を示している。

【 0 0 7 9 】

増幅する信号の帯域内の周波数間で、群遅延偏差が大きい場合、出力波形にジッタや波形の歪が生じる。図 1 0 によれば、寄生容量の有り無しでは群遅延の傾向に大きな差がないことが分かる。従来のインダクタを用いた C M L 回路の場合、1 G H z での群遅延 2 4 p s に対して、1 0 G H z 超の高周波のピークでの群遅延は最大 1 4 0 p s となり、最大で 1 1 6 p s の群遅延偏差を示す。一方、第 2 実施例のインダクタを用いた C M L 回路の場合、1 G H z での群遅延 1 7 p s に対して、1 0 G H z 超の高周波のピークでの群遅延は最大 5 9 p s となり、最大で 4 2 p s の群遅延偏差に抑えられる。このように、第 2 実施例のインダクタを用いた C M L 回路では、従来のインダクタを用いた C M L 回路と比較して群遅延偏差が約 3 . 7 分の 1 になり、帯域を延伸するだけでなく、出力波形のジッタや歪を低減できるという効果が得られる。

【 0 0 8 0 】

なお、図 9、図 1 0 では、第 2 実施例の効果について説明しているが、第 1 実施例についても第 2 実施例と同等以上の効果が得られる。その理由は、第 1 実施例の場合、第 2 実

10

20

30

40

50

施例と比較してインダクタの金属配線間の距離が遠くなり、線間容量が小さくなるからである。

【0081】

図4から明らかのように、正相側の第1のシリーズインダクタL13Pには、正相側の第1のシャントインダクタL11Pの内周と正相側の第2のシャントインダクタL12Pの内周とに挟まれる領域に形成される部分と、正相側の第1のシャントインダクタL11Pの内周と正相側の第2のシャントインダクタL12Pの外周とに挟まれる領域に形成される部分とが存在する。これら2つの領域のどちらに正相側の第1のシリーズインダクタL13Pが形成されていても構わない。正相側の第1のシャントインダクタL11Pと正相側の第1のシリーズインダクタL13Pの隣接した配置と巻き込み方向が相互インダクタンスの値と正負を決定する。

10

【0082】

同様に、逆相側の第1のシリーズインダクタL13Nには、逆相側の第1のシャントインダクタL11Nの内周と逆相側の第2のシャントインダクタL12Nの内周とに挟まれる領域に形成される部分と、逆相側の第1のシャントインダクタL11Nの内周と逆相側の第2のシャントインダクタL12Nの外周とに挟まれる領域に形成される部分とが存在する。これら2つの領域のどちらに逆相側の第1のシリーズインダクタL13Nが形成されていても構わない。第1のシャントインダクタL11Nと第1のシリーズインダクタL13Nの隣接した配置と巻き込み方向が相互インダクタンスの値と正負を決定する。

【産業上の利用可能性】

20

【0083】

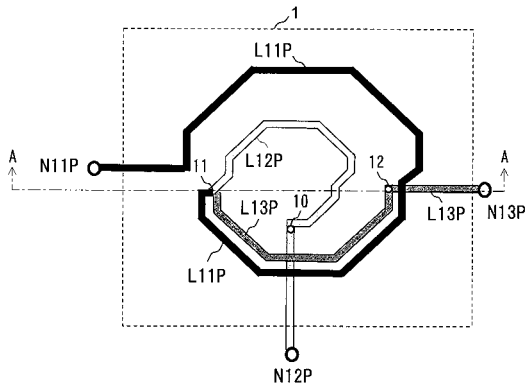
本発明は、半導体集積回路の周波数帯域を延伸するピーキング回路等に使用されるインダクタに適用することができる。

【符号の説明】

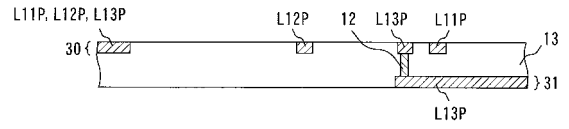
【0084】

1, 1a...インダクタ、10, 12, 14~21...コンタクト、11...接続点、13...絶縁層、30, 31...金属配線層、L11P, L12P, L11N, L12N...シャントインダクタ、L13P, L13N...シリーズインダクタ、M1, M2, M3, M4...MOSトランジスタ、IS1...電流源、R1, R2...負荷抵抗。

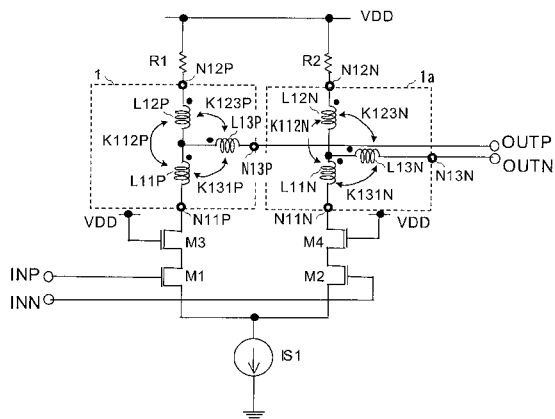
【 図 1 】



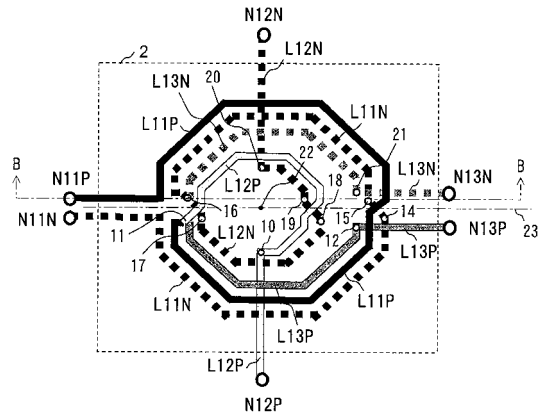
【 図 2 】



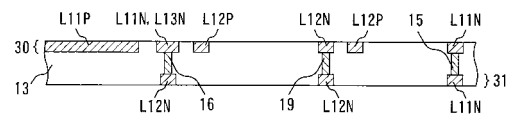
【 図 3 】



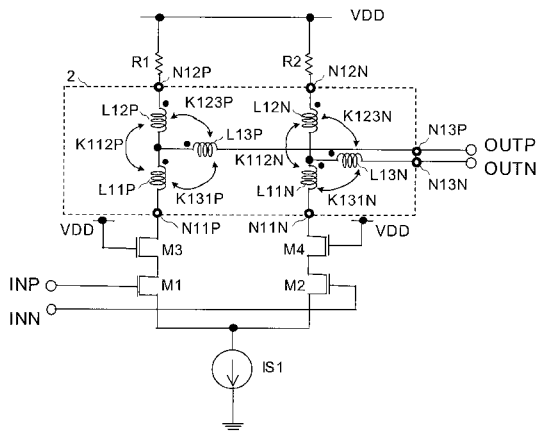
【 図 4 】



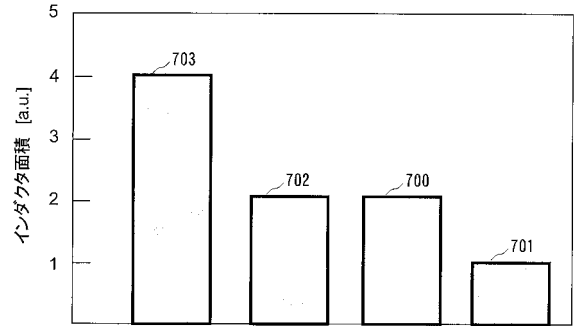
【 図 5 】



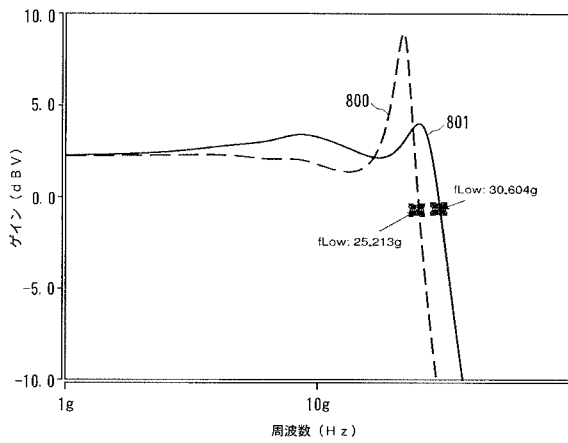
【図 6】



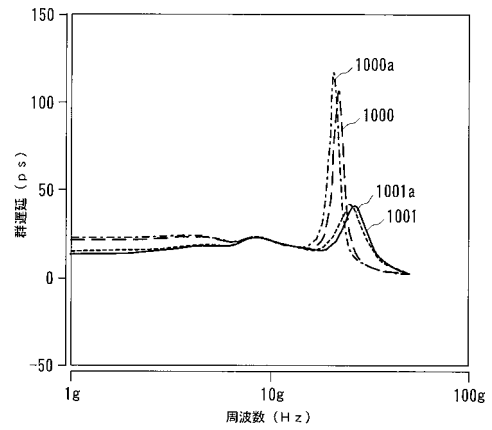
【図 7】



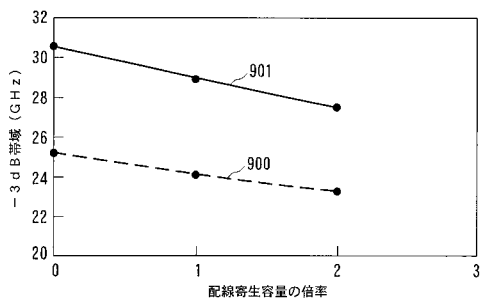
【図 8】



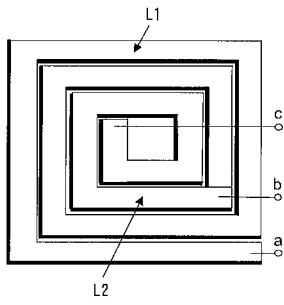
【図 10】



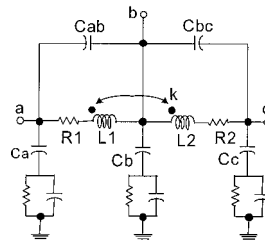
【図 9】



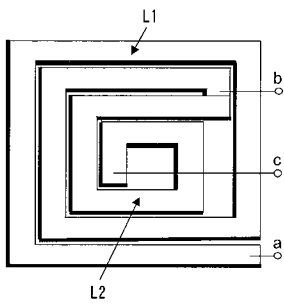
【 図 1 1 A 】



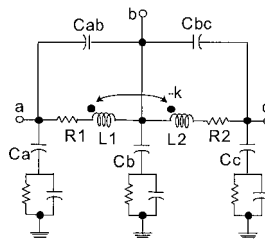
【 図 1 1 C 】



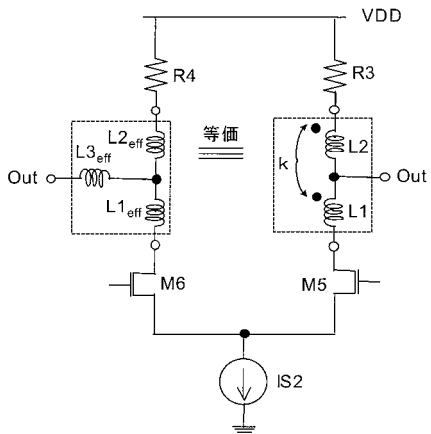
【 図 1 1 B 】



【 図 1 1 D 】



【 図 1 2 】



【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2011/070993

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER H01L21/822(2006.01)i, H01L27/04(2006.01)i, H03F3/45(2006.01)i		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) H01L21/822, H01L27/04, H03F3/45		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2011 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2011 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2011		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2007/110915 A1 (Fujitsu Ltd.), 04 October 2007 (04.10.2007), entire text; all drawings & US 2009/0066394 A1	1-8
A	JP 2005-73234 A (Fujitsu Ltd.), 17 March 2005 (17.03.2005), entire text; all drawings & US 2005/0104661 A1	1-8
A	JP 8-78964 A (Fujitsu Ltd.), 22 March 1996 (22.03.1996), fig. 8, 9 and the explanations thereof (Family: none)	1-8
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents:		
"A"	document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"E"	earlier application or patent but published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"L"	document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"O"	document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	"&" document member of the same patent family
"P"	document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	
Date of the actual completion of the international search 05 October, 2011 (05.10.11)		Date of mailing of the international search report 18 October, 2011 (18.10.11)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2011/070993

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2001-274330 A (Matsushita Electric Works, Ltd.), 05 October 2001 (05.10.2001), entire text; all drawings (Family: none)	1-8
A	JP 2007-5798 A (Infineon Technologies AG.), 11 January 2007 (11.01.2007), entire text; all drawings & US 2006/0284718 A1 & DE 102006027586 A	1-8

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2011/070993									
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. H01L21/822(2006.01)i, H01L27/04(2006.01)i, H03F3/45(2006.01)i											
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. H01L21/822, H01L27/04, H03F3/45											
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2011年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2011年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2011年</td> </tr> </table>				日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2011年	日本国実用新案登録公報	1996-2011年	日本国登録実用新案公報	1994-2011年
日本国実用新案公報	1922-1996年										
日本国公開実用新案公報	1971-2011年										
日本国実用新案登録公報	1996-2011年										
日本国登録実用新案公報	1994-2011年										
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)											
C. 関連すると認められる文献											
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号									
A	WO 2007/110915 A1 (富士通株式会社) 2007.10.04, 全文全図 & US 2009/0066394 A1	1-8									
A	JP 2005-73234 A (富士通株式会社) 2005.03.17, 全文全図 & US 2005/0104661 A1	1-8									
A	JP 8-78964 A (富士通株式会社) 1996.03.22, 図 8,9 及びその説明 箇所 (ファミリーなし)	1-8									
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。											
* 引用文献のカテゴリー		の日の後に公表された文献									
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの		「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの									
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの		「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの									
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)		「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの									
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献		「&」同一パテントファミリー文献									
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願											
国際調査を完了した日 05.10.2011		国際調査報告の発送日 18.10.2011									
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 井原 純	4 L 4666								
		電話番号 03-3581-1101 内線 3498									

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 1 / 0 7 0 9 9 3
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2001-274330 A (松下電工株式会社) 2001. 10. 05, 全文全図 (ファミリーなし)	1-8
A	JP 2007-5798 A (インフィネオン テクノロジーズ アクチエンゲゼルシャフト) 2007. 01. 11, 全文全図 & US 2006/0284718 A1 & DE 102006027586 A	1-8

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA

(72)発明者 桂井 宏明

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日本電信電話株式会社内

(72)発明者 小野寺 秀俊

京都府京都市左京区吉田本町 国立大学法人京都大学大学院情報学研究科内

(72)発明者 土谷 亮

京都府京都市左京区吉田本町 国立大学法人京都大学大学院情報学研究科内

Fターム(参考) 5E070 AA01 AB07 BA01 CB03 CB12

5F038 AZ04 CD12 CD13 EZ10 EZ20

5J500 AA12 AC62 AC87 AC92 AF16 AH10 AH36 AK02 AK05 AK13

AM17 AQ04 AS01 AS14 AT01 DN01 DN22 DN23 DP02

(注)この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。